

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第7部門第2区分  
 【発行日】平成26年10月2日(2014.10.2)

【公開番号】特開2012-109546(P2012-109546A)  
 【公開日】平成24年6月7日(2012.6.7)  
 【年通号数】公開・登録公報2012-022  
 【出願番号】特願2011-228657(P2011-228657)  
 【国際特許分類】

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/28 (2006.01)

H 0 1 L 29/417 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 29/78 6 1 6 V

H 0 1 L 29/78 6 1 8 B

H 0 1 L 29/78 6 1 6 U

H 0 1 L 29/78 6 1 6 T

H 0 1 L 21/28 3 0 1 B

H 0 1 L 29/50 M

【手続補正書】

【提出日】平成26年8月18日(2014.8.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ゲート電極層と、

前記ゲート電極層上にゲート絶縁層と、

前記ゲート絶縁層上にチャネル領域を含む半導体層と、

前記半導体層上のバッファ層と、

前記バッファ層上にソース電極層及びドレイン電極層とを含むトランジスタを有し、

前記半導体層はインジウム、ガリウム、及び亜鉛を含む酸化物半導体層であり、

前記バッファ層は、インジウム、スズ、シリコンを含む酸化物層であり、

前記半導体層と前記ソース電極層及び前記ドレイン電極層とは前記バッファ層を介して電氣的に接続することを特徴とする半導体装置。

【請求項2】

請求項1において、

前記バッファ層は、抵抗率が1 cmより大きいことを特徴とする半導体装置。

【請求項3】

請求項1または請求項2において、

前記バッファ層は、抵抗率の異なる複数の層で構成されることを特徴とする半導体装置

。